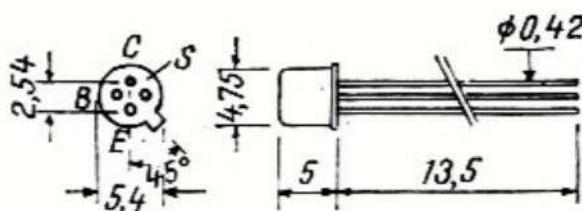


BF 183 este un tranzistor planar epitaxial destinat folosirii ca oscilator VHF în receptoare de televiziune precum și utilizărilor în general în VHF și UHF.

*The planar epitaxial transistor BF 183 is intended for use in VHF oscillator stages of television receivers and generally for all VHF-UHF uses.*



Capsulă

Outline

JEDEC

**TO-72**Dimensiuni (*Dimensions*) în mm.Greutate (*Weight*) 0,4 g.**Valori limită absolute ( $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ )***Absolute maximum ratings*

Tensiunea colector-bază <i>Collector-base voltage</i>	$V_{CBO}$	30	V
Tensiunea emitor-bază <i>Emitter-base voltage</i>	$V_{EBO}$	3	V
Tensiunea colector-emitor <i>Collector-emitter voltage</i>	$V_{CEO}$	20	V
Curentul de colector <i>Collector current</i>	$I_C$	20	mA
Puterea totală disipată <i>Total power dissipation</i>	$P_D$		
$T_{amv} = 25^\circ\text{C}$		200	mW
$T_c = 20^\circ\text{C}$		375	mW
Temperatura jonctiunii <i>Junction temperature</i>	$T_j$	175	°C
Temperatura de stocare <i>Storage temperature</i>	$T_{stg}$	-65...+175	°C

Rezistență termică jonețiune-mediu ambiant în aer liniștit	$R_{thj-a}$	750	°C/W
<i>Thermal resistance from junction to ambient in free air</i>			
Rezistență termică jonețiune-capsulă <i>Thermal resistance from junction to case</i>	$R_{thj-c}$	400	°C/W
<b>Caracteristici statice (<math>T_{amb} = 25^\circ\text{C}</math>)</b> <i>D.C. characteristics</i>			
Curentul rezidual de colector <i>Collector cutoff current</i> $I_E = 0; V_{CB} = 20 \text{ V}$	$I_{CBO}$	1	nA
Tensiunea de străpungere colector-bază <i>Collector to base breakdown voltage</i> $I_B = 0; I_C = 10 \mu\text{A}$	$V_{(BR)CBO}$	30	V
Tensiunea de străpungere colector- emitor <i>Collector to emitter breakdown voltage</i> $I_B = 0; I_C = 2 \text{ mA}$	$V_{(BR)CEO}$	20	V
Tensiunea de străpungere emitor-bază <i>Emitter to base breakdown voltage</i> $I_C = 0; I_E = 10 \mu\text{A}$	$V_{(BR)EBO}$	3	V
Raportul de transfer în curent direct static <i>D.C. forward current transfer ratio</i> $I_C = 3 \text{ mA}; V_{CE} = 10 \text{ V}$	$h_{21E}$	70(> 10)	
Tensiunea bază emitor <i>Base to emitter voltage</i> $-I_E = 3 \text{ mA}; V_{CB} = 10 \text{ V}$	$V_{BE}$	0,8	V
<b>Caracteristici dinamice (<math>T_{amb} = 25^\circ\text{C}</math>)</b> <i>Small signal characteristics</i>			
Frecvența de tranziție <i>Transition frequency</i> $I_C = 3 \text{ mA}; V_{CB} = 10 \text{ V}; f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	800	MHz
Capacitatea de reacție (emitor comun) <i>Feedback capacitance (common emitter)</i> $I_C = 1 \text{ mA}; V_{CB} = 10 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	$C_{12e}$	0,3	pF
Ciștigul maxim în putere <i>Maximum power gain</i> $I_C = 3 \text{ mA}; V_{CB} = 10 \text{ V}; f = 900 \text{ MHz}$	$G_{pM}$	14	dB

Parametrii  $y$  ( $y$  parameters) în bază comună (common base)

$-I_E = 3 \text{ mA}; V_{CB} = 10 \text{ V}$

Conductanță de intrare  
*Input conductance*

Suscepțanță de intrare  
*Input susceptance*

Admitanță de reacție în modul  
*Modulus of feedback admittance*

Unghiul de fază al admitanței de reacție  
*Phase angle of feedback admittance*

Admitanță de transfer în modul  
*Modulus of transfer admittance*

Unghiul de fază al admitanței de transfer  
*Phase angle of transfer admittance*

Conductanță de ieșire  
*Output conductance*

Capacitatea de ieșire  
*Output capacitance*

$f$   
50    200    500    900    MHz

$g_{11b}$     80    55    20    5    mS

$-b_{11b}$     15    35    35    15    mS

$|y_{12b}|$     60    230    450    800     $\mu\text{S}$

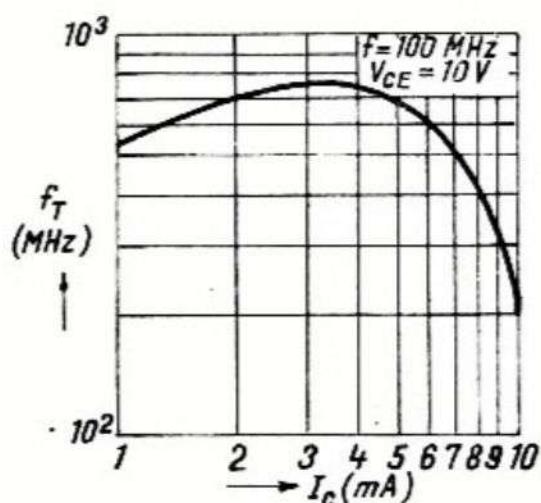
$-\Phi_{12b}$     90    90    90    90     $^{\circ}$

$|y_{21b}|$     85    65    38    15    mS

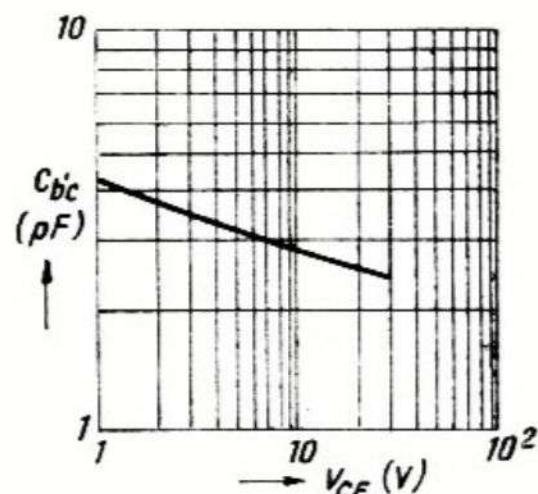
$\Phi_{21b}$     150    130    80    50     $^{\circ}$

$g_{22b}$     10    55    350    1 000     $\mu\text{S}$

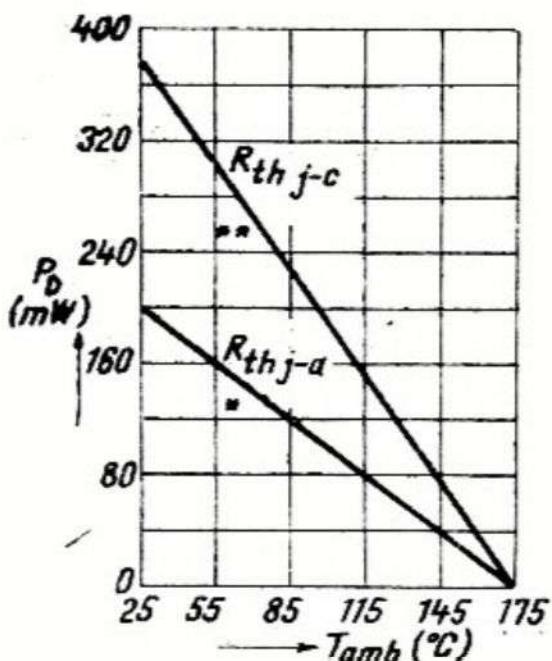
$C_{22b}$     1    1    1    1    pF



Frecvența de tranziție  
*Transition frequency*



Capacitatea colector-bază  
*Collector-base capacitance*



Puterea maximă disipată în funcție de temperatura ambiantă

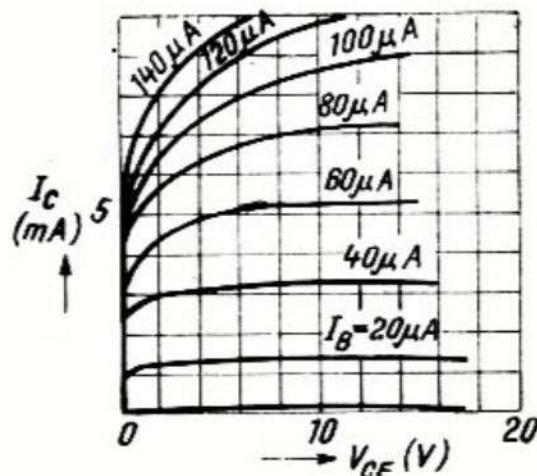
*Maximum dissipation vs. ambient temperature*

\*În aer liniștit

(In free air)

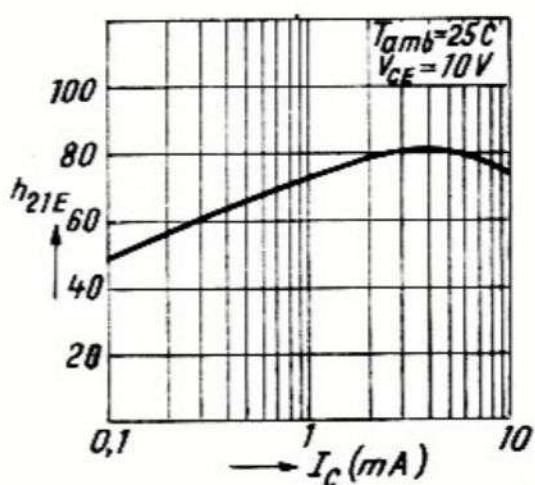
\*\*Cu radiator infinit

(With infinite heat sink)

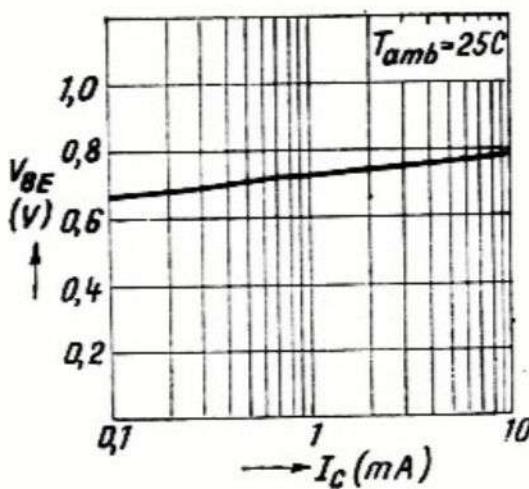


Caracteristici de ieșire

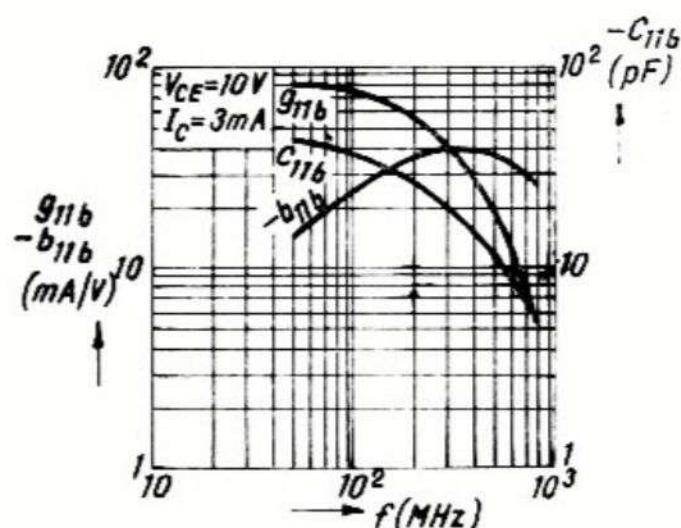
*Output characteristics*



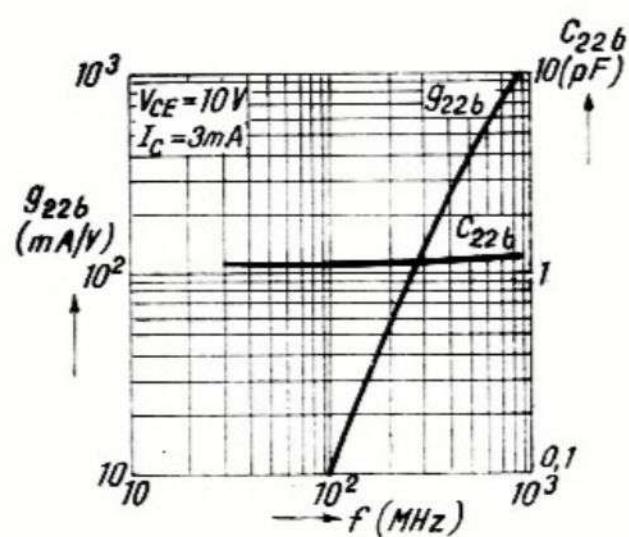
Amplificare în curent static  
*DC current gain*



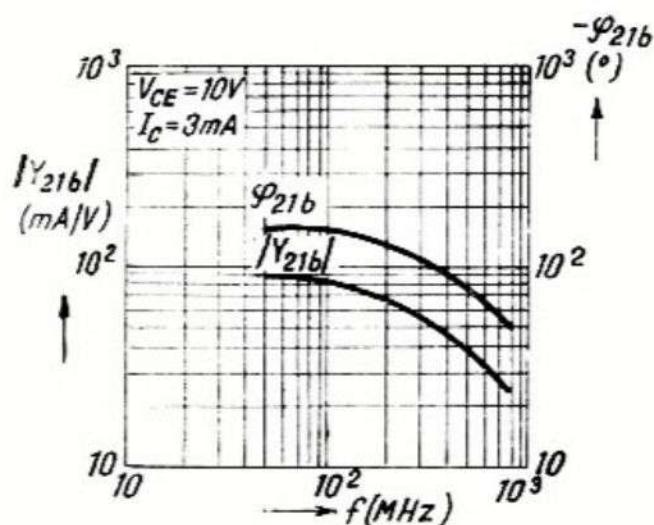
Tensiune bază-emitor  
*Base-emitter voltage*



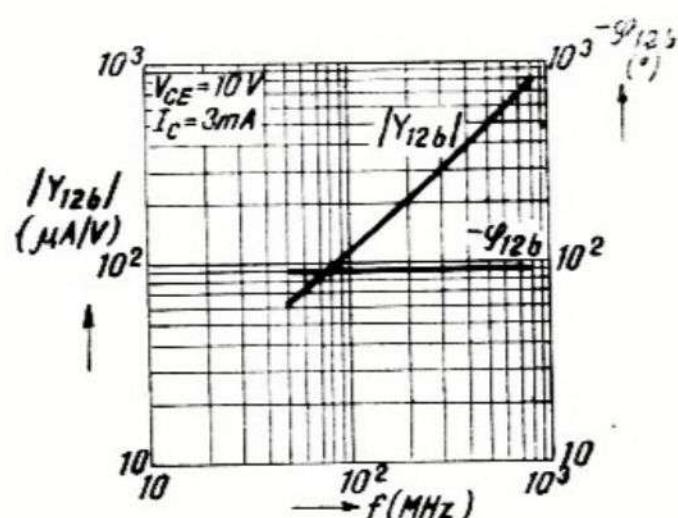
Parametrii  $Y_{11b}$  în funcție de frecvență  
 $Y_{11b}$  parameters vs. frequency



Parametrii  $Y_{22b}$  în funcție de frecvență  
 $Y_{22b}$  parameters vs. frequency



Parametrii  $Y_{21b}$  în funcție de frecvență  
 $Y_{21b}$  parameters vs. frequency



Parametrii  $Y_{12b}$  în funcție de frecvență  
 $Y_{12b}$  parameters vs. frequency